

	<h2 style="color: red;">SI4866DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4866DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4866DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 164762 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4866DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	164762 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 17A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4866DY-T1-E3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 11A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount 8-SO
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)

SI4866DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4866DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4866DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4866DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4872DY VIS SI4872DY VIS</p>	 <p>SI4866DY VISHAY SI4866DY VISHAY</p>	 <p>SI4866DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p>	 <p>SI4866DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p>
 <p>SI4866DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 11A 8-SOIC</p>	 <p>SI4872DY-T1-E3 V SI4872DY-T1-E3 V</p>	 <p>SI4866BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 21.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4866BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 21.5A 8-SOIC</p>

SI4866DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4866DY-T1-E3 Datenblatt	SI4866DY-T1-E3-Datenblätter	SI4866DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4866DY-T1-E3
SI4866DY-T1-E3 Electronic	SI4866DY-T1-E3-Komponenten	SI4866DY-T1-E3-Verteiler	SI4866DY-T1-E3-Bild	SI4866DY-T1-E3-Teil
SI4866DY-T1-E3 Preis	SI4866DY-T1-E3 Hersteller	SI4866DY-T1-E3 Bild	SI4866DY-T1-E3 Aktie	SI4866DY-T1-E3 Inventar
SI4866DY-T1-E3 Neu	SI4866DY-T1-E3 Original	SI4866DY-T1-E3 garantiert	SI4866DY-T1-E3 RFQ	SI4866DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited